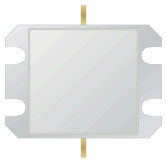
5700–7100 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 51 dBm (tipico)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN Transistor di potenza con adattamento interno.



Valori della tabella RF: PSAT 51 dBm (tipico); Guadagno di potenza 11 dB (tipico); PAE 45 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Vg: C = 10 µF

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	5700	-	7100	MHz
Potenza di uscita satura	-	50.5	51	-	dBm
Guadagno di potenza	-	10.5	11	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	-	40	45	-	%
Planarità del guadagno di potenza	-	-	-	1.5	dB

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione operativa del drain	-	-	-	-	28	V
Tensione operativa del gate	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	-	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	-	-5	-	-	V
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Potenza di ingresso massima	-	-	-	42	dBm

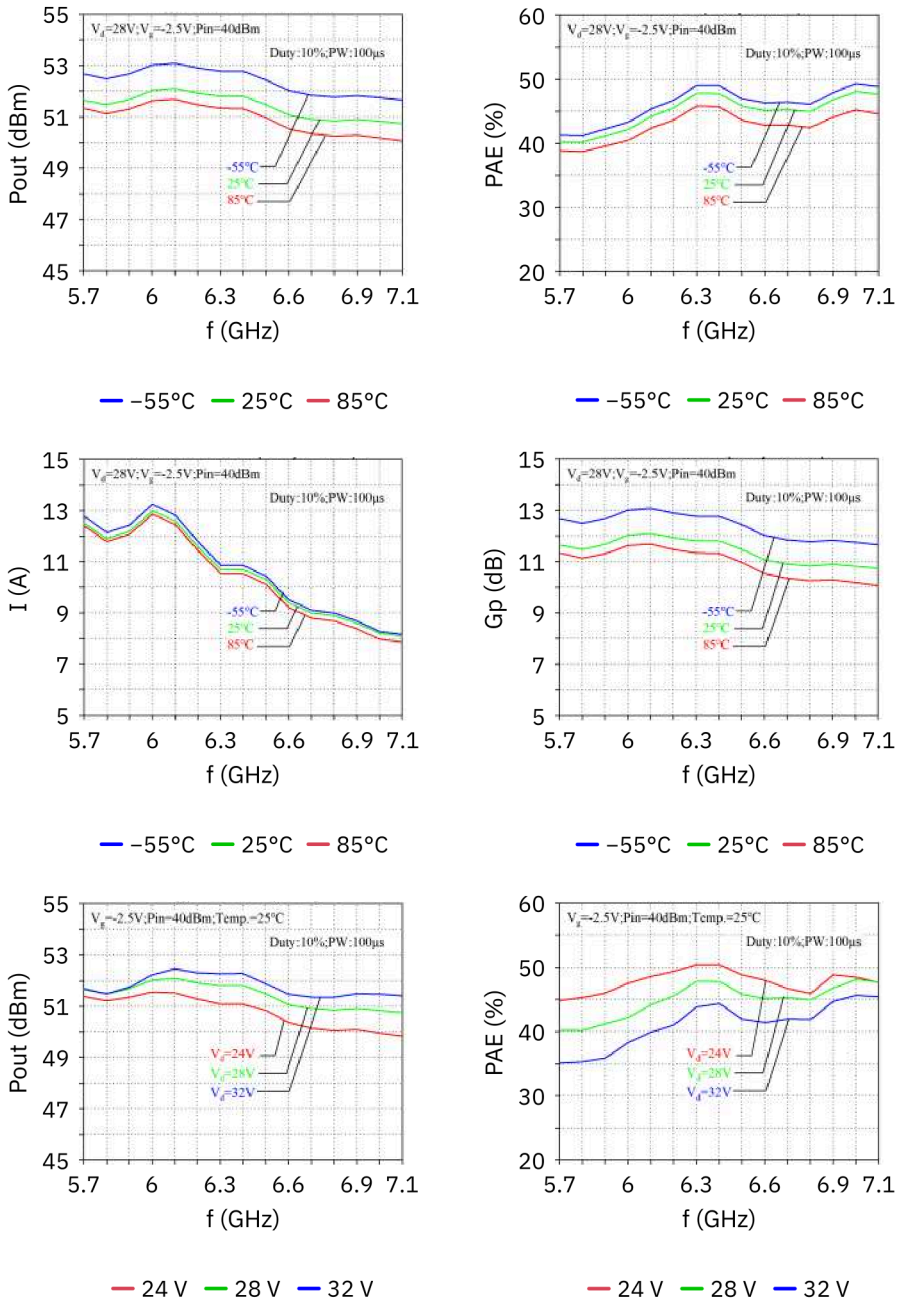
Pubblicazione corrente · 1.5 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.4.

Note di integrazione

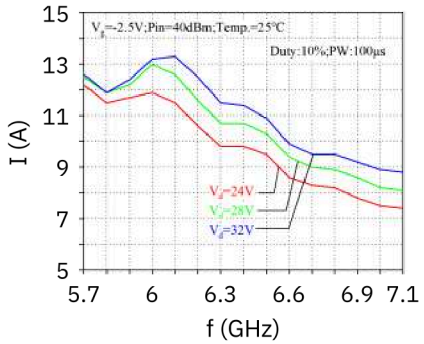
CMW025B Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Vg: C = 10 µF G: Ingresso RF D: Uscita RF S: Source / massa

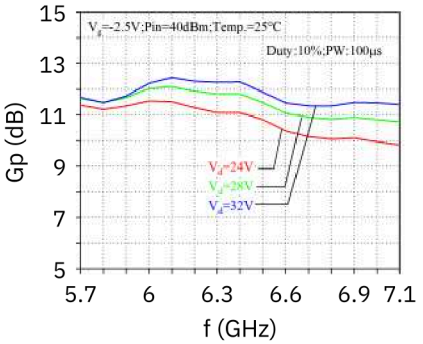
Curve di prestazione

Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.



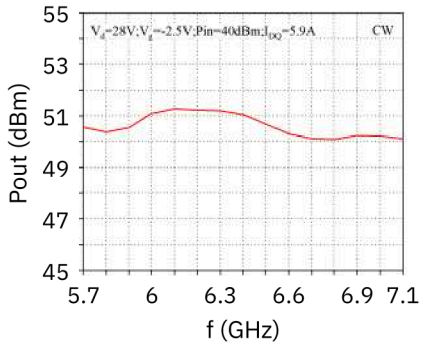
Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain; Guadagno di potenza. Grafici 1–4: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs; Temp = −55 / +25 / +85°C. Grafici 5–6: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs.

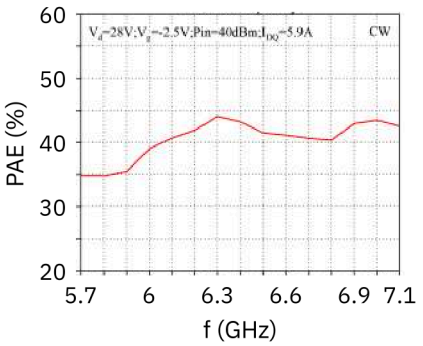


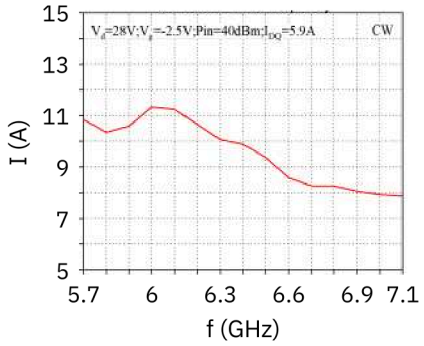


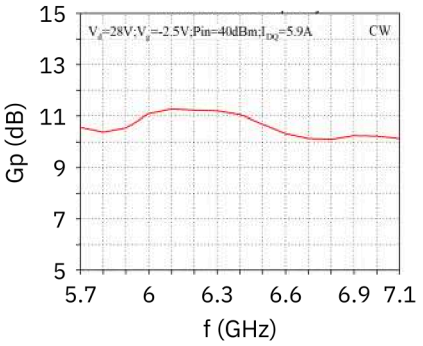
24 V 28 V 32 V

24 V 28 V 32 V

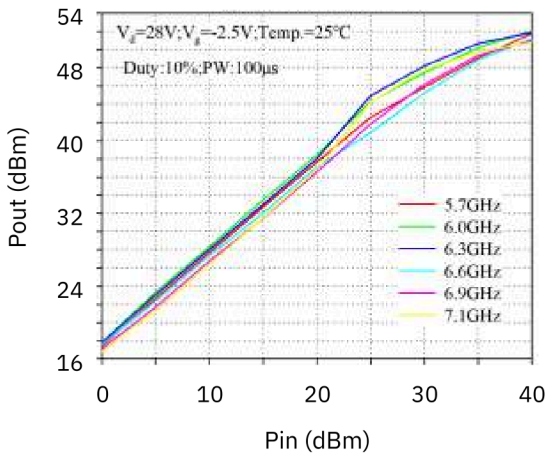


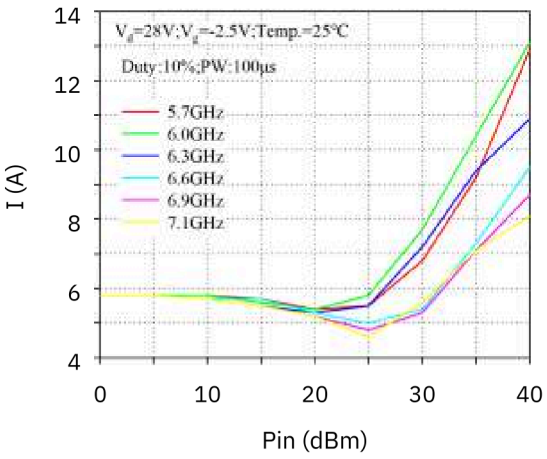






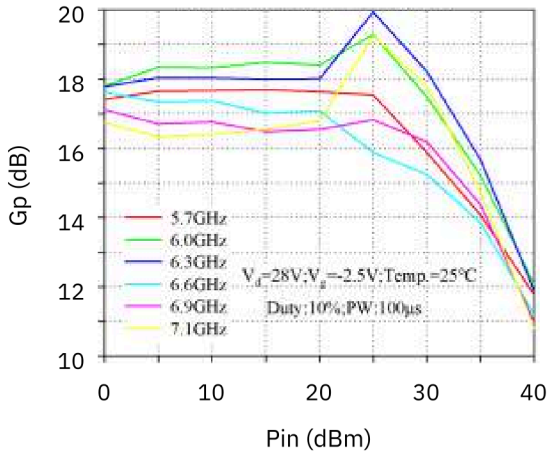
Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain; Guadagno di potenza. Grafici 1–2: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs. Grafici 3–6: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

Potenza di uscita; Corrente di drain; Guadagno di potenza. Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.